

2013年3月期 決算説明会

 新日本無線株式会社

2013年5月13日



2013年3月期決算について

2013年3月期決算サマリー

(単位:百万円)

	2012年3月期	2013年3月期	増 減
売 上 高	40,272	36,417	△3,855
営 業 利 益	△4,101	1,469	+5,570
当期純利益	△9,098	1,721	+10,819

- ・主力のベースライン製品は堅調に推移するも、受託生産販売が大幅に減少。
- ・事業構造改革の成果(固定費圧縮)により、利益は計画を大幅に上回る。
- ・2013年3月期平均為替レート: 1US\$=¥82.33

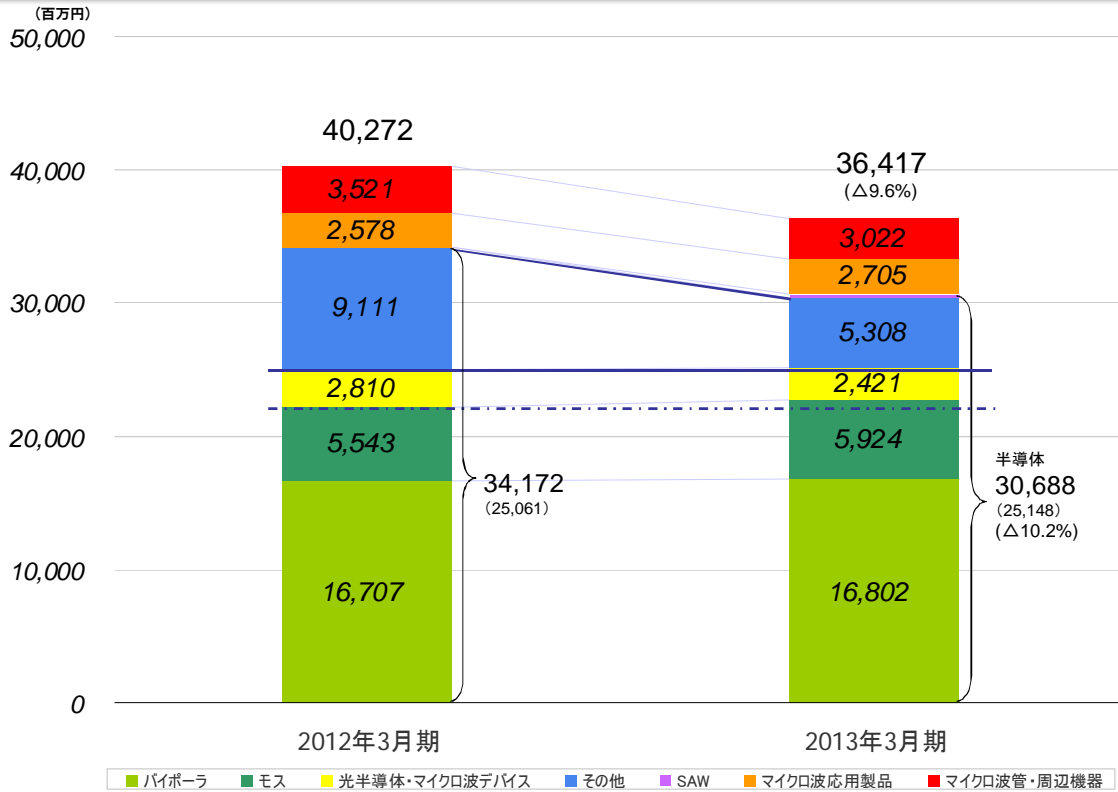
2013年3月期セグメント別業績

(単位:百万円)

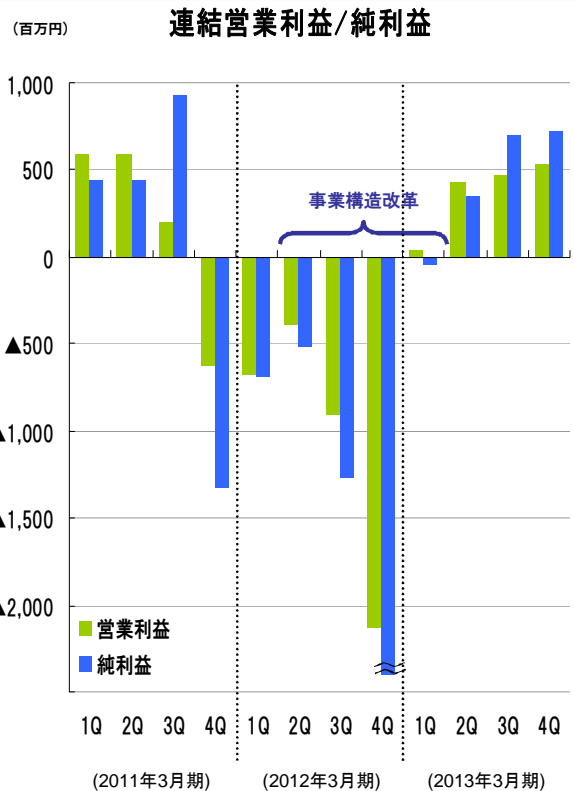
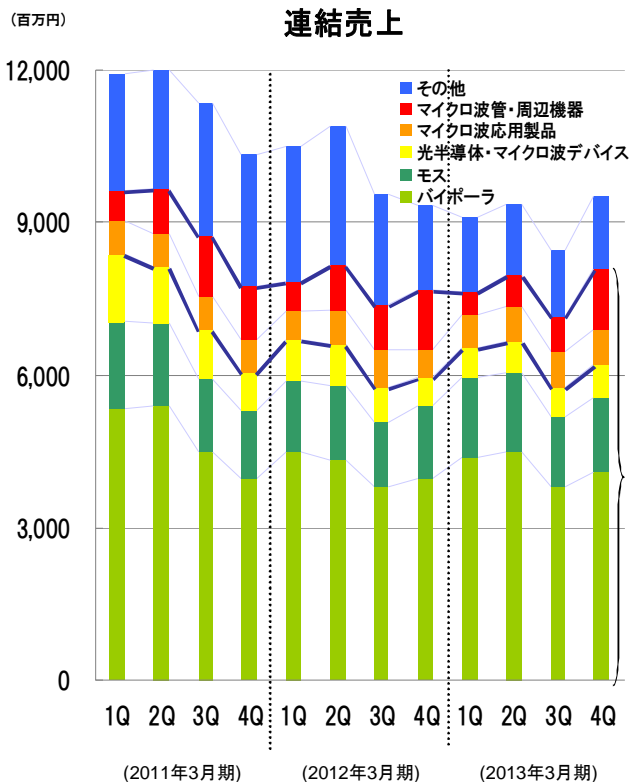
	12年3月期	13年3月期	増 減	増減率
売 上 高	40,272	36,417	△3,855	△9.6%
マイクロ波管・周辺機器	3,521	3,022	△498	△14.2%
マイクロ波応用製品	2,578	2,705	+127	+4.9%
半導体	34,172	30,688	△3,483	△10.2%
営 業 利 益	△4,101	1,469	+5,570	—
マイクロ波管・周辺機器	450	370	△79	△17.7%
マイクロ波応用製品	△95	177	+272	—
半導体	△2,705	2,360	+5,066	—

※各セグメント営業利益は、調整額控除前の営業利益

2013年3月期売上高(前期比)

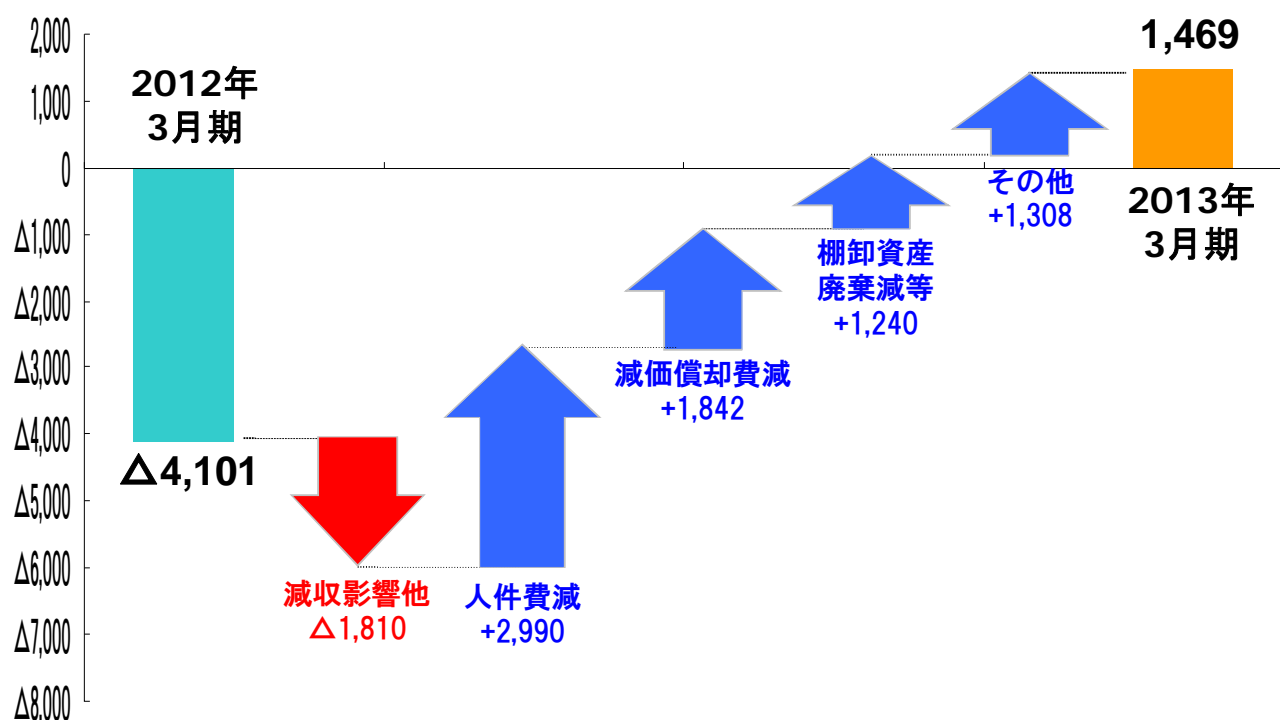


業績推移(四半期別)



2013年3月期営業利益分析

(百万円)



2013年3月期費用等実績(前期比)

(百万円)

	12年3月期	13年3月期	増減	増減率
人件費	16,635	13,646	△2,990	△17.9%
経費	7,762	7,214	△548	△7.0%
減価償却費	3,546	1,705	△1,842	△51.9%
研究開発費	4,769	3,361	△1,408	△29.5%
設備投資	3,091	2,199	△892	△28.8%

2014年3月期計画について

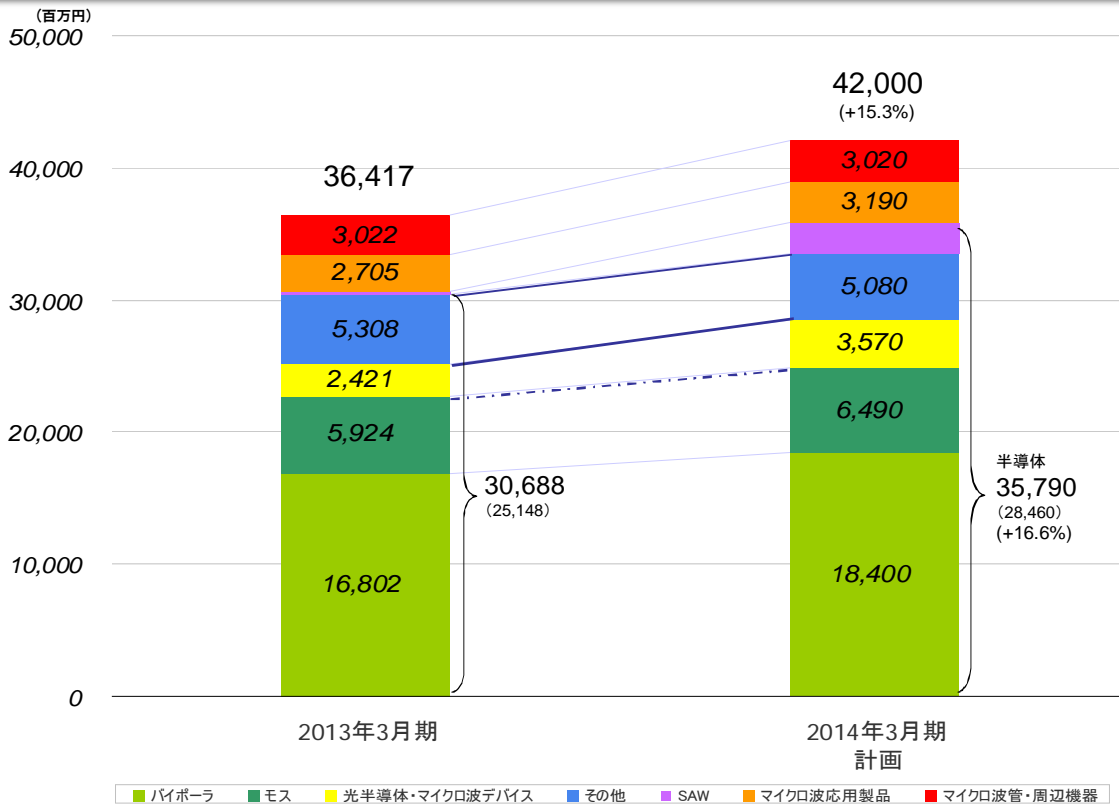
2014年3月期計画

(百万円)

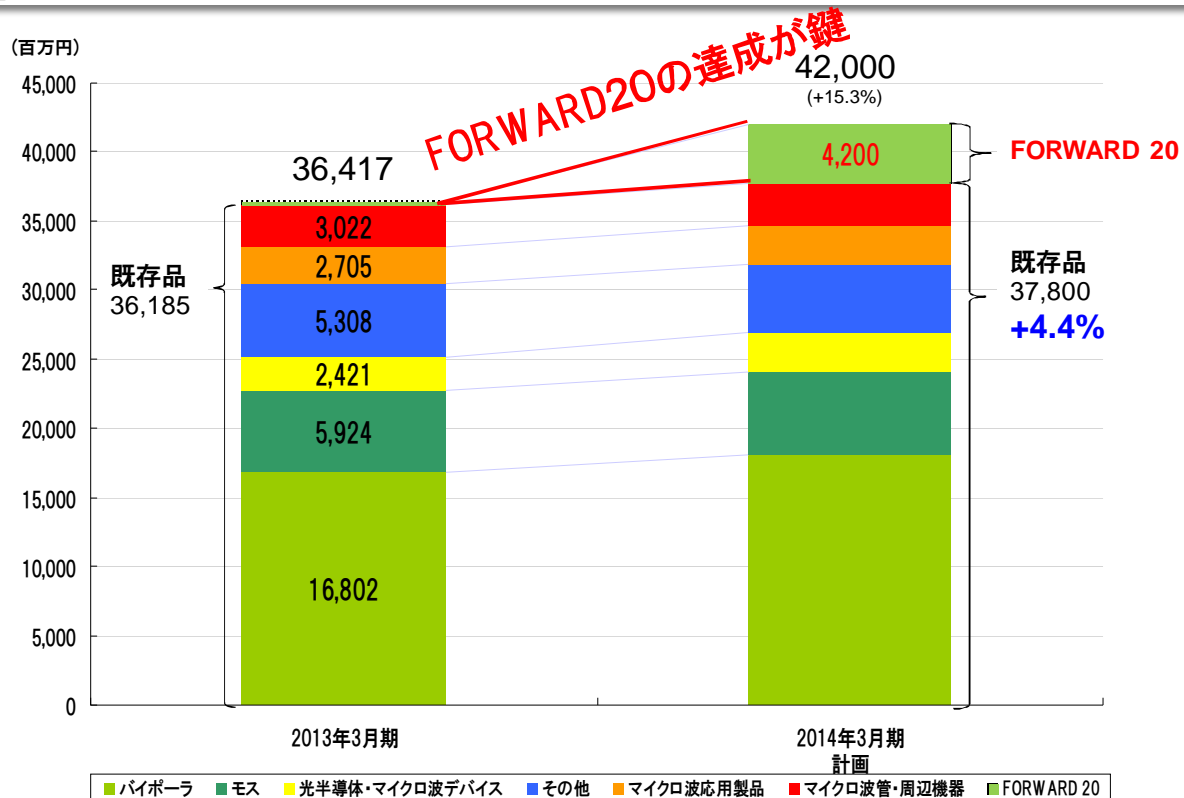
	13年3月期	14年3月期(計画)			増減	増減率
		上期	下期	通期		
売上高	36,417	20,000	22,000	42,000	5,583	15.3%
営業利益	1,469	850	1,650	2,500	1,031	70.1%
当期純利益	1,721	700	1,400	2,100	379	22.0%

・計画上の為替レート: 1US\$=¥85.00

2014年3月期売上高計画(前期比)

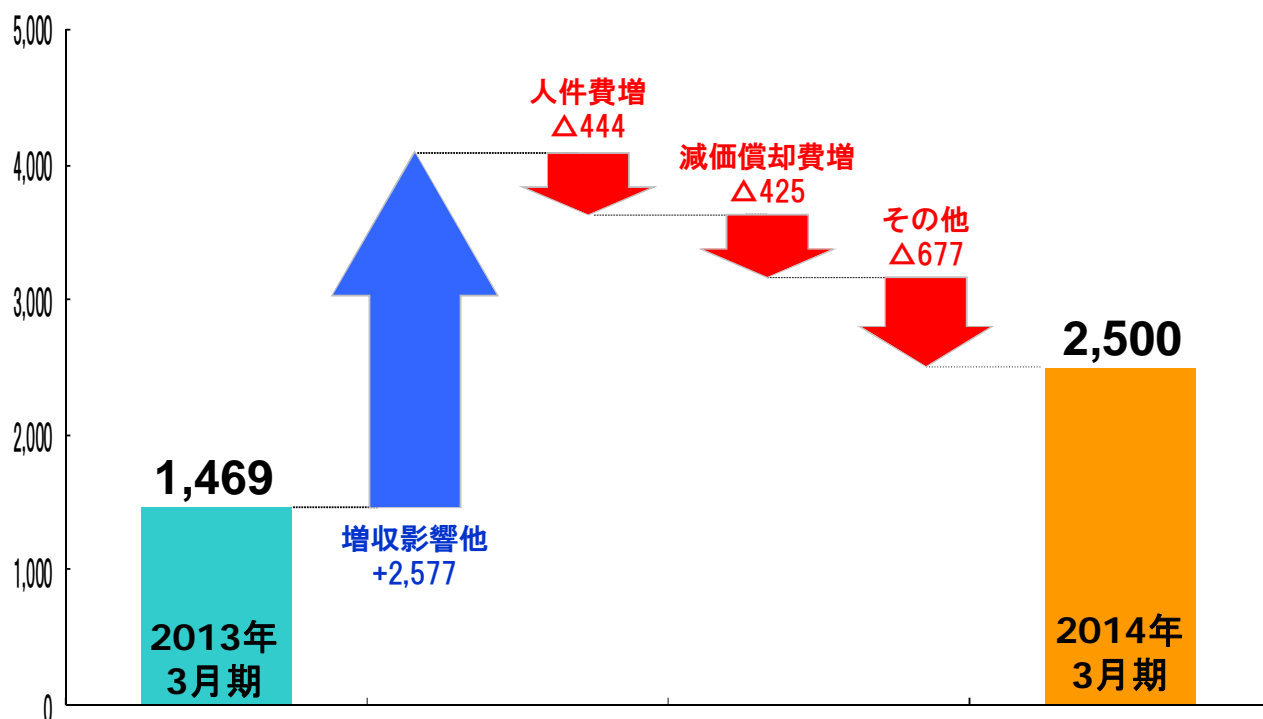


2014年3月期売上高計画(前期比)(3)



2014年3月期営業利益分析

(百万円)



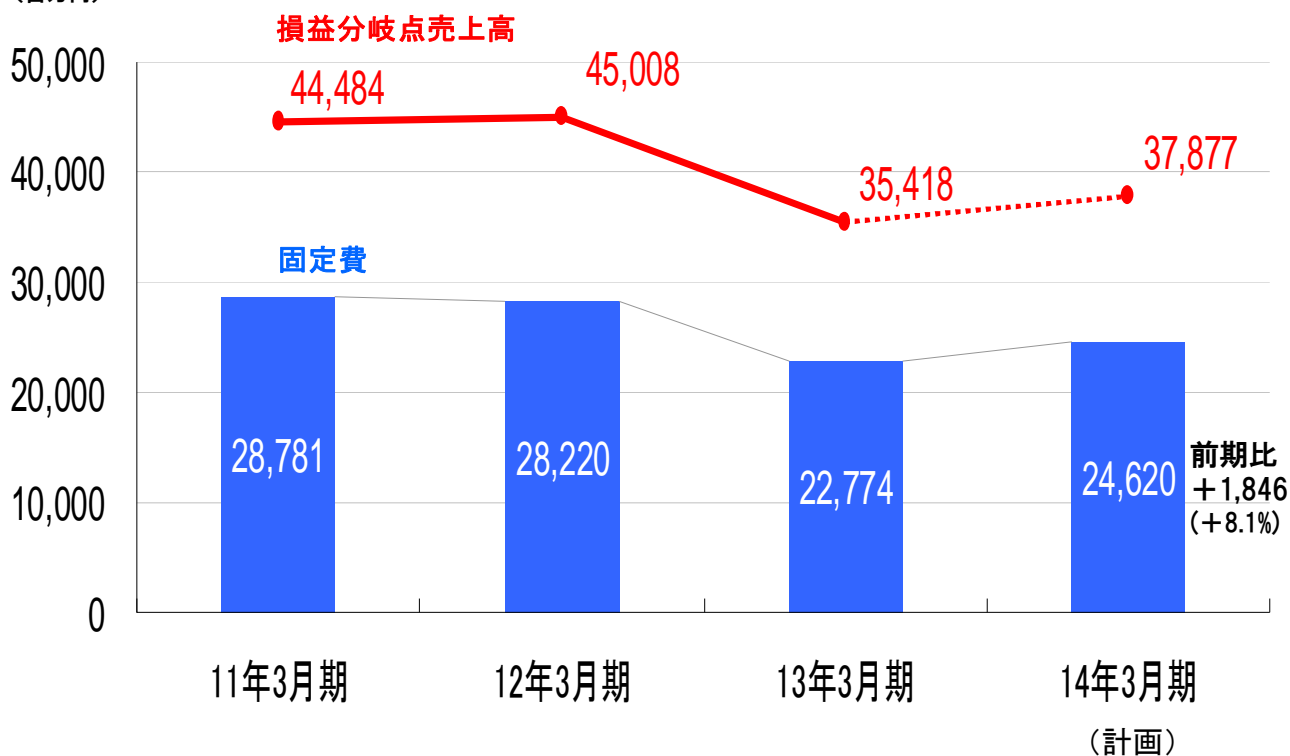
2014年3月期費用等計画(前期比)

(百万円)

	13年3月期	14年3月期 (計画)	増 減	増減率
人 件 費	13,646	14,090	444	3.2%
経 費	7,214	8,300	1,086	15.1%
減価償却費	1,705	2,130	425	24.9%
研究開発費	3,361	3,950	589	17.5%
設備投資	2,199	2,400	201	9.1%

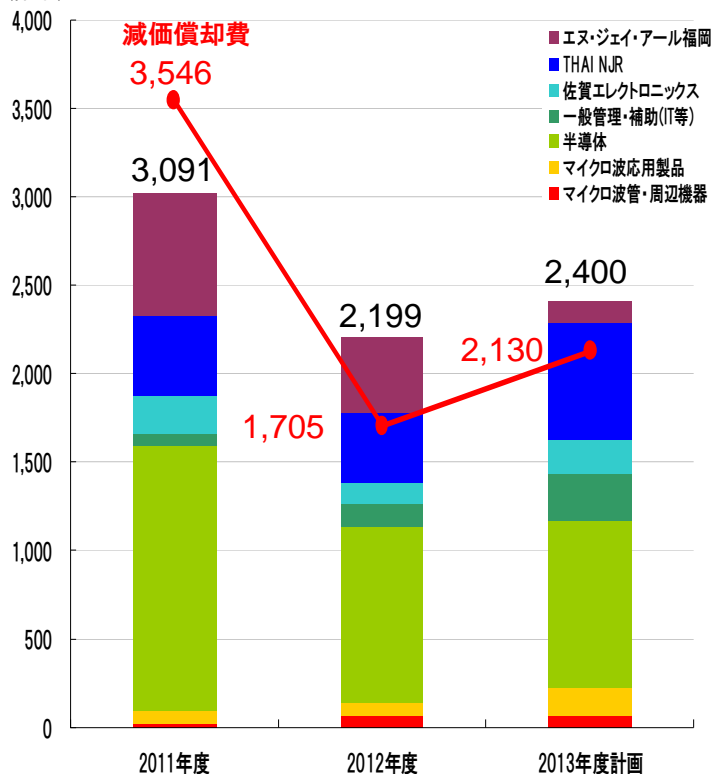
損益分岐点売上高推移

(百万円)

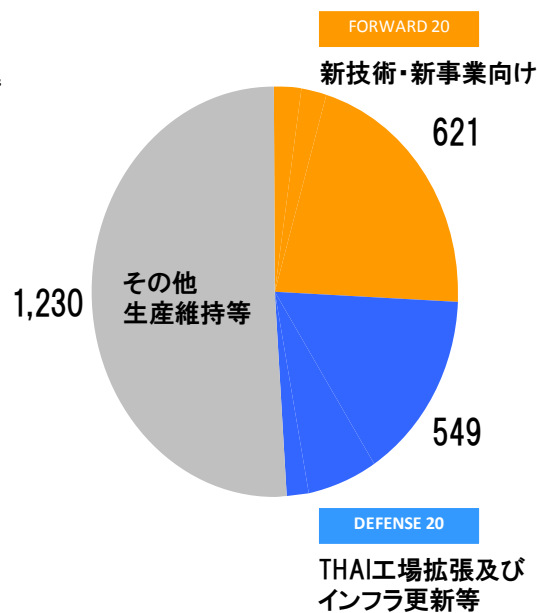


設備投資額推移

(百万円)



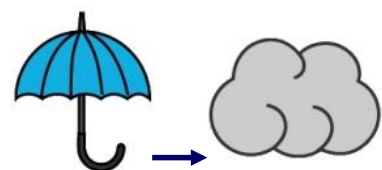
2013年度の主な投資案件



今後の成長戦略

■ 当社を取り巻く事業環境

- **歴史的な円高**
(激変する為替水準)



- **世界的な景気減速**
(一部改善の兆しも、予断できず)



- **主要顧客の変容**
(加速する半導体業界再編)



1. 事業構造改革の完遂

「固定費圧縮」によるコスト競争力向上

2. 成長戦略(売上拡大)

DEFENSE 20

FORWARD 20

DEFENSE 20

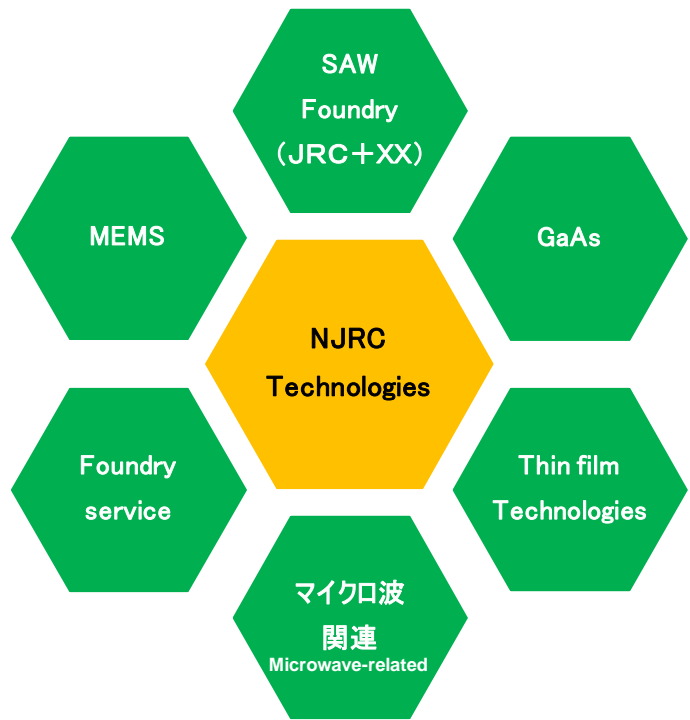


ベースライン製品の強化、拡充

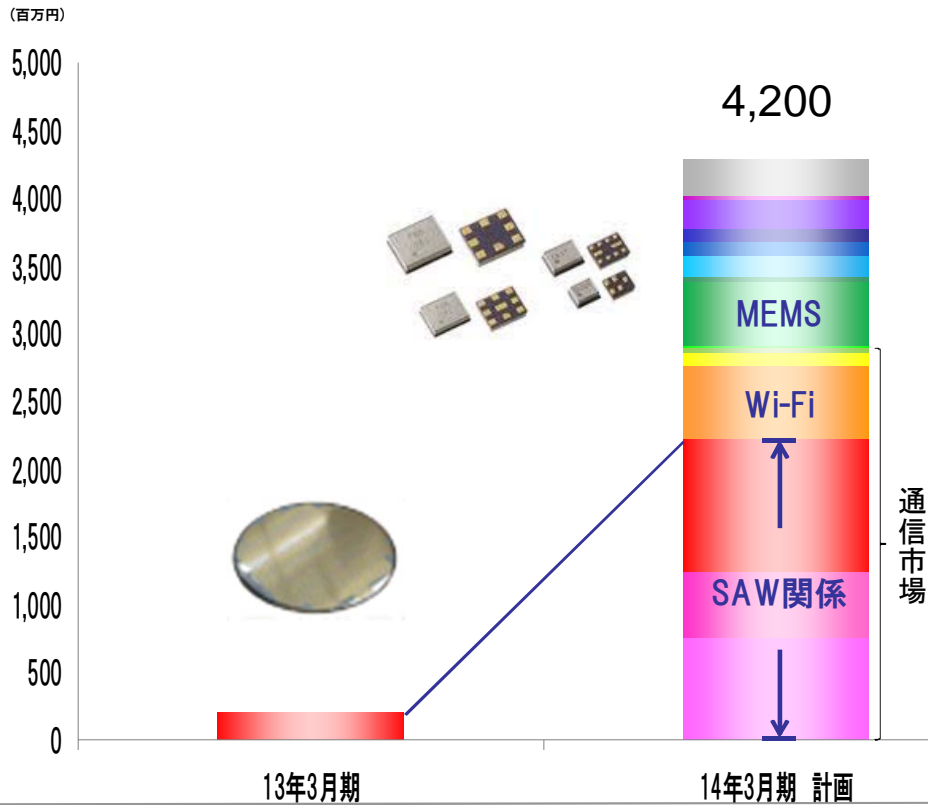
FORWARD 20



コアテクノロジーとビジネス展開



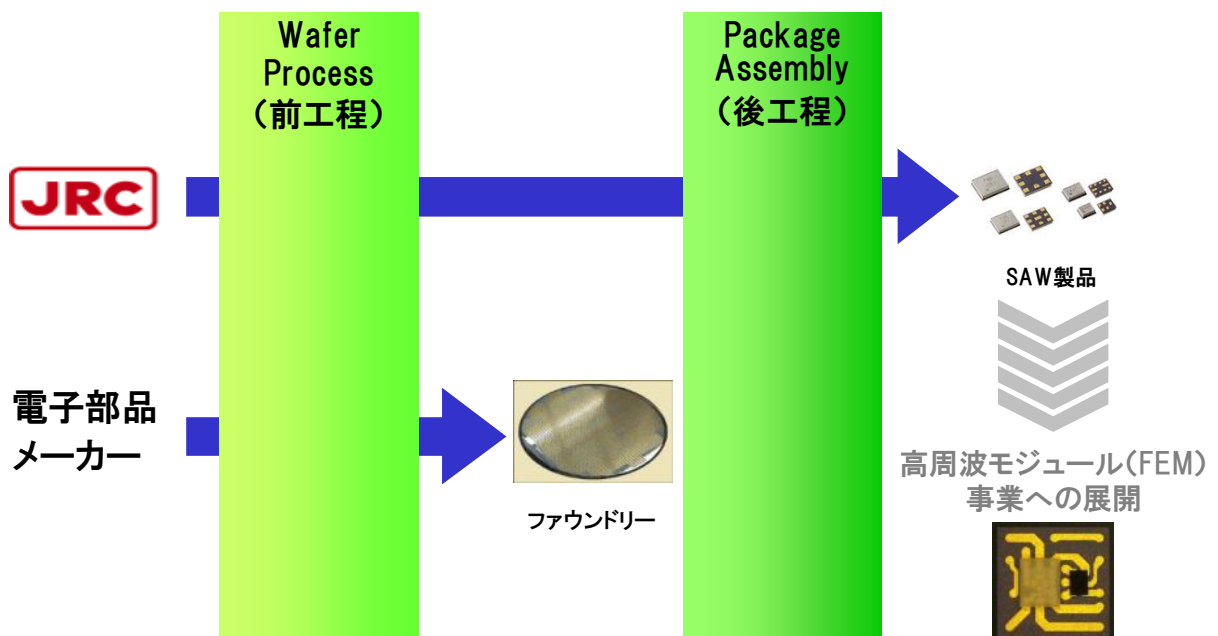
FORWARD 20 売上高計画



22

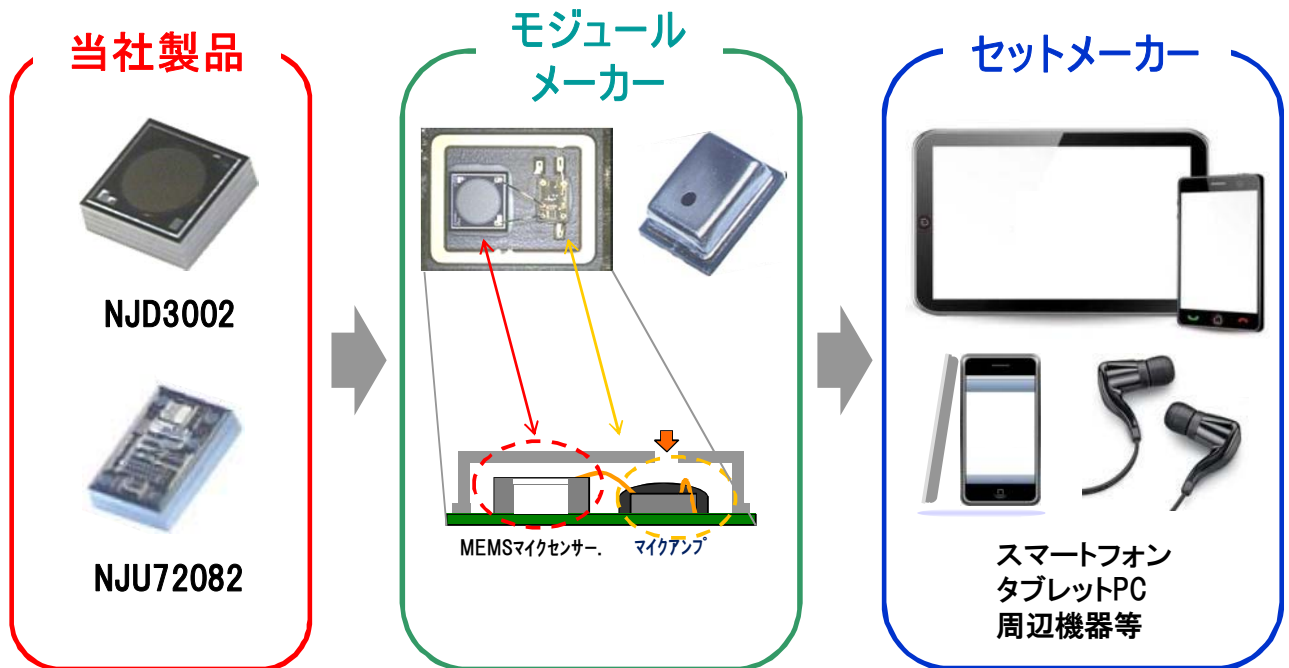
SAW事業の事業構造

日本無線からの事業移管 + ファウンドリービジネス

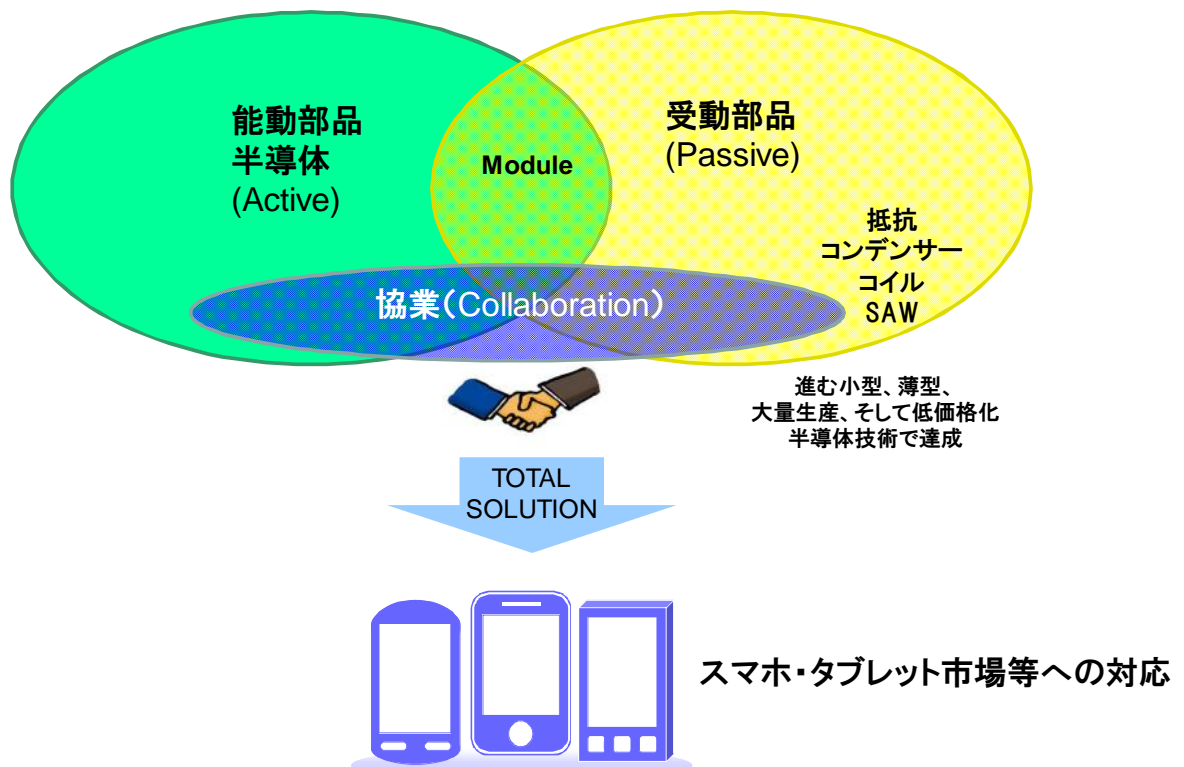


23

MEMSマイクとアプリケーション例

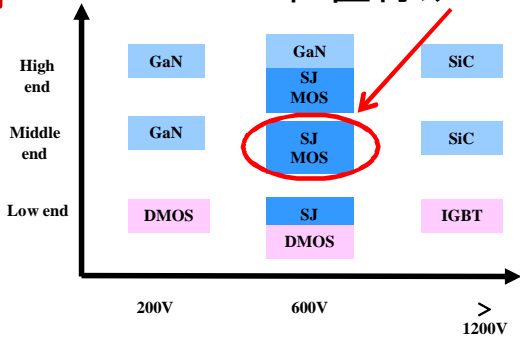


電子部品メーカーとの協業



次世代パワーデバイス(SJ MOSFET)

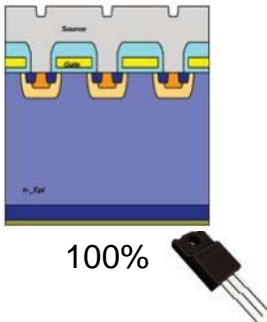
SJ MOSFETの位置付け



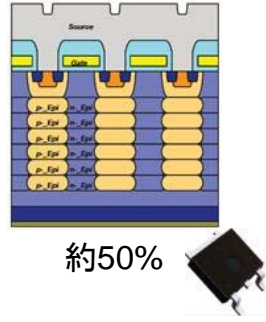
技術開発・量産の状況



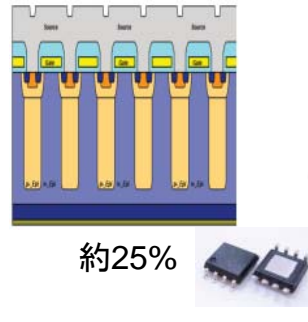
DMOS FET



Multi Epi SJ FET



Trench埋込Epi



THAI NJR(半導体後工程工場)拡張



Thai NJR 敷地面積:
54,566 m²

新工場 敷地面積:
3,528 m²

現工場 敷地面積:
9,957 m²

着工: 2013年4月
完成: 2014年1月



ご清聴ありがとうございました。

 *New Japan Radio Co., Ltd.*